



19 BUNDESREPUBLIK

# 12 Offenlegungsschrift

51 Int. Cl.<sup>6</sup>

10 DE 197 34 794 A 1

H 01 L 23 495  
H 01 L 21 60



DEUTSCHES  
PATENTAMT

3 Aktenzeichen: 197 34 794.0  
3 Anmeldetag: 11. 8. 97  
3 Offenlegungstag: 15. 7. 98

DE 197 34 794 A 1

32 Unionspriorität:  
P 2310/97 09. 01. 97 JP  
31 Anmelder:  
Mitsubishi Denki F.K., Tokio/Tokyo, JP  
34 Vertreter:  
Tiedtke, Bühling, Finne & Partner, 80336 München

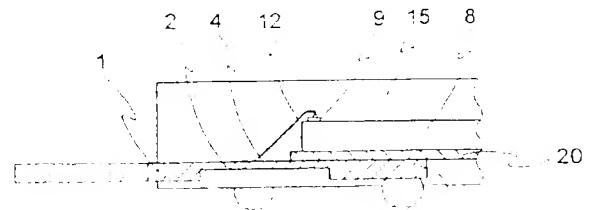
33 Erfinder:  
Takahashi, Yoshiharu, Tokio/Tokyo, JP

## Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen

Prüfungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt

54 Verdrahtungsteil und Leiterraum mit dem Verdrahtungsteil

57 Es wird ein Verdrahtungsteil mit einem ersten Elektrodenabschnitt (4), der mit einer an einer Oberfläche eines Halbleiterelements (8) ausgebildeten Elektrode elektrisch verbunden ist, einem zweiten Elektrodenabschnitt (5), der mit einer an einer externen Schaltung ausgebildeten Elektrode elektrisch verbunden ist, und einem Verdrahtungsabschnitt (2) geschaffen, der den ersten Elektrodenabschnitt (4) mit dem zweiten Elektrodenabschnitt (5) verbindet. Der erste Elektrodenabschnitt (4), der zweite Elektrodenabschnitt (5) und der Verdrahtungsabschnitt (2) sind aus einem plattenförmigen leitenden Körper (1) ausgebildet, wobei die Dicke des Verdrahtungsabschnitts (2) nicht größer als die Hälfte der Dicke des ersten Elektrodenabschnitts (4), oder des zweiten Elektrodenabschnitts (5), ausgeführt ist. Eine Feinverdrahtung kann dadurch erreicht werden, indem der Leiter als Verdrahtungsteil zur elektrischen Verbindung der Halbleiterelementelektroden (9) mit den Außenelektroden der Halbleitervorrichtung nicht größer als die Hälfte der erforderlichen Dicke des Leiterraummaterials ausgeführt wird.



100 101 12 8 20

DE 34 794 A 1

DE

Die Bründung betrifft ein Verdrahtungsteil zur Verwendung bei einer Halbleitervorrichtung und einen Leiterahmen mit dem Verdrahtungsteil.

In letzter Zeit ist im Zusammenhang mit der höheren Integration und der höheren Dichte von Halbleitervorrichtungen die Anzahl der Eingabe-/Ausgabeanschlüsse von Halbleiterelementen angestiegen und die Unterteilungsbreite der Anschlüsse enger geworden.

Eine Größe und die Unterteilungsbreite von Halbleiterelementelektroden, die an den Oberflächen von einer Halbleitervorrichtung, nämlich Halbleiterelementen, vorgesehen sind, unterscheiden sich von denen der Außenelektroden, die beispielsweise auf der äußeren Oberfläche der Halbleitervorrichtung vorgesehen sind. Deshalb ist zur elektrischen Verbindung der Halbleiterelementelektroden und der Außenelektroden der Halbleitervorrichtung ein Verdrahtungsteil erforderlich.

Als Verdrahtungsteil ist ein Leiterahmen oder eine gedruckte Leiterplatte verwendet worden. Die Verdrahtung mit einem Leiterahmen kann als eine Einschichtverdrahtung zur Verbindung erster Elektrodenabschnitte, die mit den auf den Oberflächen der Halbleiterelemente vorgesehenen Halbleiterelementelektroden über Metalldrähte oder dergleichen elektrisch verbunden sind, mit zweiten Elektrodenabschnitten definiert werden, bei denen es sich um die Außenelektroden der Halbleitervorrichtung handelt. Demgegenüber kann die Verdrahtung mit einer Leiterplatte als eine Mehrschichtverdrahtung zur elektrischen Verbindung der ersten Elektrodenabschnitte, die mit den Halbleiterelementelektroden über Metalldrähte oder dergleichen elektrisch verbunden sind, mit den zweiten Elektrodenabschnitten, bei denen es sich um die Außenelektroden der Halbleitervorrichtung handelt, unter Verwendung von auf den Oberflächen von zumindest zwei Schichten einer doppelseitigen Platte oder einer Mehrschichtplatte vorgesehenen leitenden Verdrahtungen und außerdem eines Durchgangslochs definiert werden, das die bei den unterschiedlichen Schichten ausgebildeten leitenden Verdrahtungen elektrisch verbindet.

Fig. 22 zeigt eine Schnittansicht einer Halbleitervorrichtung, bei der eine beispielsweise in der japanischen Offenlegungsschrift 79 652/1982 offenbarten herkömmliche Leiterplatte angewendet ist. In dieser Darstellung bezeichnet die Bezugszahl 8 ein Halbleiterelement, 9 eine an der Oberfläche des Halbleiterelements ausgebildete Halbleiterelementelektrode, 10 eine gedruckte Leiterplatte, an deren Oberfläche das Halbleiterelement 8 angebracht ist, 11 eine an der Oberfläche der gedruckten Leiterplatte 10 ausgebildete leitende Verdrahtung, 12 einen Metalldraht, 13 ein Durchgangsloch, 14 einen an der rückwärtigen Oberfläche der gedruckten Leiterplatte 10 ausgebildeten Außenanschluß und 15 ein Vergußharz. Bei der mit Harz vergossenen Halbleitervorrichtung, bei der das Halbleiterelement 8 an der gedruckten Leiterplatte 10 angebracht ist und mit dem Vergußharz 15 vergossen bzw. abgedichtet ist, ist die an der Oberfläche des Halbleiterelements 8 ausgebildete Halbleiterelementelektrode 9 über den Metalldraht 12 mit einem Ende der an der oberen Oberfläche der gedruckten Leiterplatte 10 vorgesehenen leitenden Verdrahtung 11 elektrisch verbunden, wobei das eine Ende in der Nähe des Halbleiterelements 8 angeordnet ist. Das andere Ende der leitenden Verdrahtung 11

angewandt ist. Bei der Verdrahtung bezeichnet die Bezugszahl 8 ein Halbleiterelement, 9 eine an der Oberfläche des Halbleiterelements ausgebildete Halbleiterelementelektrode und 16 eine gedruckte Mehrschicht-Leiterplatte, an deren Oberfläche das Halbleiterelement 8 angebracht ist. Die Bezugszahl 11 bezeichnet eine an der Oberfläche der gedruckten Mehrschicht-Leiterplatte 16 ausgebildete leitende Verdrahtung, 17 eine in den inneren Schichten der gedruckten Mehrschicht-Leiterplatte 16 ausgebildete interne Verdrahtung, 18 ein Blindloch zur elektrischen Verbindung aller Schichten der gedruckten Mehrschicht-Leiterplatte 16, 14 einen an der rückwärtigen Oberfläche der gedruckten Mehrschicht-Leiterplatte 16 ausgebildeten externen Anschluß, 19 ein Band (TAB-Band bzw. TAB-Film) mit einem Verdrahtungsmuster zur elektrischen Verbindung der Halbleiterelementelektrode 9 mit der an der Oberfläche der gedruckten Mehrschicht-Leiterplatte 16 ausgebildeten leitenden Verdrahtung 11 und 15 ein Vergußharz. Bei der mit Harz vergossenen Halbleitervorrichtung, bei der das Halbleiterelement 8 an der gedruckten Mehrschicht-Leiterplatte 16 angebracht ist und mit dem Vergußharz 15 vergossen ist, sind die Halbleiterelementelektrode 9 und die an der Oberfläche der gedruckten Mehrschicht-Leiterplatte 16 ausgebildete leitende Verdrahtung 11 miteinander mittels des TAB-Bands 19 elektrisch verbunden. Außerdem ist die leitende Verdrahtung 11 über das Blindloch 18 und der internen Verdrahtung 17 mit dem in der rückwärtigen Oberfläche der gedruckten Mehrschicht-Leiterplatte 16 ausgebildeten Außenanschluß 14 verbunden. Bei der in der japanischen Offenlegungsschrift 258.048/1988 offenbarten Halbleitervorrichtung kann ein Halbleiterelement mit mehr Anschlüssen als das in der japanischen Offenlegungsschrift 79 652/1982 offenbarte Halbleiterelement 8 angebracht werden, da bei dieser das gedruckte Mehrschicht-Leiterplatte 16 mit der internen Verdrahtung 17 und dem Blindloch 18 sowie das TAB-Band 19 angewandt wird.

Wenn als Verdrahtungsteil zur elektrischen Verbindung der Elektroden an den Oberflächen der Halbleiterelemente mit den Außenelektroden der Halbleitervorrichtung eine Leiterplatte verwendet wird, wird eine Kupferfolie mit einer Dicke von 25 µm bis 75 µm bei den Verdrahtungsteilen verwendet, wodurch ermöglicht wird, eine Verdrahtungsunterteilungsbreite von 50 µm bis 150 µm auszubilden. Zusätzlich sind die Außenelektroden einer Halbleitervorrichtung mit einem großen Verdrahtungsabstand aufgrund der Ausbildung eines Lötanschlusses (eine Lotwulbung) oder dergleichen an der Oberfläche ausgebildet, die der Oberfläche gegenüberliegend angeordnet ist, an der die Halbleiterelemente angebracht sind, damit die Größe der Halbleitervorrichtung verringert werden kann.

Fig. 24 zeigt eine Schnittansicht einer Halbleitervorrichtung, die einen herkömmlichen Leiterahmen anwendet. Bei dieser Darstellung bezeichnet die Bezugszahl 8 ein Halbleiterelement, 9 eine an der Oberfläche des Halbleiterelements ausgebildete Halbleiterelementelektrode, 20 ein Befestigungsplättchen, an dem das Halbleiterelement angebracht ist, 21 ein Befestigungsharz bzw. einen Kleber, der das Halbleiterelement an das Befestigungsplättchen 20 klebt, 4 einen ersten Elektrodenabschnitt des Leiterahmens, 5 einen zweiten Elektrodenabschnitt des Leiterahmens, 12 einen dünnen Metalldraht zur elektrischen Verbindung der Halbleiterelementelektrode 9 mit dem ersten Elektrodenabschnitt 4.

Beschreibung des Herstellungsverfahrens des Leiterrahmens durch einen herkömmlichen Atzvorgang. Bei dieser Darstellung bezeichnet die Bezugszahl 1 eine leitende Metallplatte (ein Leiterahmenmaterial) mit einer Dicke von 125 bis 200 µm und 3 eine Atzmaske mit einem vorbestimmten Muster, wobei dasselbe Muster auf beiden Oberflächen der leitenden Metallplatte 1 ausgebildet sind. Die Bezugszahl 2 bezeichnet einen Verdrahtungsabschnitt des Leiterrahmens, der durch Ätzen der leitenden Metallplatte 1 von beiden Oberflächen erzeugt wird, damit ein nicht von der Atzmaske bedeckter Abschnitt durchdrungen wird. Da der herkömmliche Leiterrahmen auf diese Weise hergestellt wird, wenn die leitende Metallplatte 1 mit einer Dicke von 125 µm bis 200 µm verwendet wird, muß der Abstand zwischen benachbarten Verdrahtungsabschnitten 2 etwa so groß wie die Dicke der leitenden Metallplatte 1 sein. Außerdem lag zur Gewährleistung des Atzvorgangs die minimale Unterteilungsbreite (pitch) des Leiterrahmens in einem Bereich von 210 µm bis 250 µm, was etwa doppelt so groß wie die Dicke der leitenden Metallplatte 1 ist.

Zur Verkleinerung der Unterteilungsbreite des herkömmlichen Leiterrahmens sind bei Definition des mit einer Halbleiter-elementelektrode durch Drahtbonden verbundenen Abschnitts des Leiterrahmens als ein erster Elektrodenabschnitt und des an eine externe Schaltung gelöteten Abschnitts als ein zweiter Elektrodenabschnitt Verfahren zur Verringerung der Dicke des ersten Elektrodenabschnitts durch Ätzen und darauffolgendes Verkleinern des Verdrahtungsabstands in den japanischen Offenlegungsschriften 45 967/1990 und 335 804/1995 offenbart. Fig. 26 zeigt den Vorgang zur Herstellung des Leiterrahmens, die in der japanischen Offenlegungsschrift 335 804/1995 offenbart ist. Bei dieser Darstellung stellt die Bezugszahl 1 eine leitende Metallplatte, bei der es sich um ein Leiterahmenmaterial handelt, 3a und 3b Atzmasken und 4 den ersten Elektrodenabschnitt 4 dar. Die an einer Oberfläche der leitenden Metallplatte 1 ausgebildete Atzmaske 3a weist eine Öffnung zur Ausbildung des ersten Elektrodenabschnitts 4 auf, wobei die an der anderen Oberfläche der leitenden Metallplatte 1 ausgebildete Atzmaske 3b eine Öffnung zum Ätzen der anderen Oberfläche aufweist, um diese vollständig eben auszubilden. Die Bezugszahl 23 stellt eine Aussparung, die, um diese eben auszubilden, durch die Atzmaske 3a geätzt wurde, und 24 eine Atz widerstandsschicht dar. Zunächst werden die Atzmasken 3a und 3b an den Oberflächen der leitenden Metallplatte 1 ausgebildet (Fig. 26(a)), wobei der Atzvorgang an beiden Oberflächen gestartet wird und zeitweilig ausgesetzt wird, wenn die Tiefe der Aussparung 23 zwei Drittel der Dicke der leitenden Metallplatte 1 erreicht (Fig. 26(b)). Die Atz widerstandsschicht 24 ist an der Seite der leitenden Metallplatte 1 mit der Aussparung 23 ausgebildet, wodurch verhindert wird, daß der Atzvorgang weiter voranschreitet (Fig. 26(c)). Dann wird der Atzvorgang an der Seite der leitenden Metallplatte 1 mit der Öffnung zur Ausbildung des ersten Elektrodenabschnitts 4 fortgesetzt, bis das Ätzen die Atz widerstandsschicht 24 zur Ausbildung des ersten Elektrodenabschnitts 4 erreicht (Fig. 26(d)). Schließlich werden die Atz widerstandsschicht 24 und die Atzmasken 3a und 3b entfernt, wodurch der Leiterrahmen fertiggestellt wird (Fig. 26(e)). Fig. 27 zeigt eine Schnittansicht des auf diese Weise ausgebildeten Leiterrahmens. Wenn die Dicke 1 der leitenden Metallplatte 1 150 µm be-

trachtet wird, ist es schwierig, an das ein Halbleiter-element ange-

In den japanischen Offenlegungsschriften 216 524/1987 und 232 305/1992 sind Verfahren zur Verringerung der Dicke des Leiters durch Ausbildung der Atzmasken 3a und 3b auf beiden Oberflächen der leitenden Metallplatte 1, bei der es sich um Leiterahmenmaterial handelt, und zur Verkleinerung der Leiterunterteilungsbreite durch Vorsehen des Leiters auf beiden Seiten, wie in Fig. 28 gezeigt. Jedoch weist ein derartig dünner ausgeführter Leiter den Nachteil auf, daß, da geätzte Oberflächen anwesend sind, falls diese als Biege- oder zur Verbindung mittels Drahtbonden mit dem Halbleiter-element verwendet wird, sich das nahtförmige Bondenmittel zwischen der geätzten roten Oberfläche und dem Halbleiter-element ablöst.

Wie vorstehend beschrieben kann bei Verwendung einer Mehrschicht-Leiterplatte als Verdrahtungsteil eine größere Anzahl von Eingangs-/Ausgangsanschlüssen eines Halbleiter-elementes (Halbleiter-elementelektroden) und einer kleineren Unterteilungsbreite hinsichtlich der Größe verwirklicht werden. Jedoch erfordern das Durchgangsloch und das Blindloch, die in unterschiedlichen Schichten ausgebildete unterschiedliche Verdrahtungen verbinden, einen Bohrvorgang. Folglich tritt das Problem auf, daß die Kosten der Halbleiter-vorrichtung durch die Beschädigung des Bohrens, die Reinigung der gebohrten Oberflächen, den Schutz der Leiterplatte vor Schneideöl für das Bohren und vor Bohrspänen und dergleichen erhöht werden.

Demgegenüber ist bei der Verwendung eines Leiterrahmens als Verdrahtungsteil eine Technik vorgeschlagen worden, die die Leiterunterteilungsbreite verkleinert, jedoch ist für die Außenelektroden der Halbleiter-vorrichtung keine Technik vorgeschlagen. Deshalb ist ein Verdrahtungsabstand, der derselbe oder größer wie der herkömmliche ist, zwischen den ersten Elektrodenabschnitten mit kleiner Unterteilungsbreite und den zweiten Elektrodenabschnitten (Außenelektroden) mit der großen Unterteilungsbreite erforderlich. Zusätzlich tritt das Problem auf, daß eine große Unterteilungsbreite und ein großer Bereich zur Ausbildung eines Lotanschlusses oder dergleichen erforderlich ist, weshalb es folglich unmöglich ist, eine verkleinerte Halbleiter-vorrichtung zu erhalten.

Daher liegt der Erfindung die Aufgabe zugrunde, diese Probleme zu lösen und einen Aufbau zur Verkleinerung des Verdrahtungsabstands, die bisher nur durch Verwendung einer Mehrschicht-Leiterplatte verwirklicht wurde, durch Verwendung eines Leiterrahmens und Verdrahtungsteils zu verwirklichen, durch den der Leiterrahmen aufgebaut ist. Dabei soll ein Verdrahtungsteil, das eine größere Anzahl und eine kleinere Unterteilungsbreite der Stufe der Eingangs-/Ausgangsanschlüsse eines Halbleiter-elementes erreichen sowie die Verkleinerung und Kostenverringerung der Halbleiter-vorrichtung erreichen kann, sowie einen Leiterrahmen mit einem derartigen Verdrahtungsteil, geschaffen werden.

Diese Aufgabe wird durch die in den beigefügten Patentansprüchen dargelegten Maßnahmen gelöst.

Erfindungsgemäß wird ein Verdrahtungsteil geschaffen, das durch einen ersten Elektrodenabschnitt, der mit einer an einer Oberfläche eines Halbleiter-elementes ausgebildeten Elektrode elektrisch verbunden ist, einen zweiten Elektrodenabschnitt, der mit einer an einer externen Schaltung ausgebildeten Elektrode elektrisch verbunden ist, und einen Verdrahtungsabschnitt gekennzeichnet ist, der den ersten

so dick wie der erste Elektrodenabschnitt oder der zweite

gemäß dem ersten Ausführungsbeispiel.

Der Verdrahtungsabschnitt kann an einer Oberfläche des plattenförmigen leitenden Körpers vorgesehen sein.

Außerdem können die Verdrahtungsanschnitte verstreut an beiden Oberflächen des plattenförmigen leitenden Körpers angeordnet sein.

Die Dicke des ersten Elektrodenabschnitts und die Dicke des zweiten Elektrodenabschnitts können dieselbe wie die des plattenförmigen leitenden Körpers sein.

Weiterhin kann die Dicke entweder des ersten Elektrodenabschnitts oder des zweiten Elektrodenabschnitts dieselbe wie die des plattenförmigen Körpers sein, wobei die Dicke des anderen nicht mehr als die Hälfte der des plattenförmigen leitenden Körpers betragen kann.

Darüberhinaus kann der erste Elektrodenabschnitt oder der zweite Elektrodenabschnitt, deren Dicke nicht mehr als die Hälfte des plattenförmigen leitenden Körpers beträgt, gepreßt werden, um deren Oberflächen eben auszuführen.

Erfindungsgemäß wird außerdem ein Verdrahtungsstück geschaffen, das durch einen ersten Elektrodenabschnitt, der mit einer an einer Oberfläche eines Halbleiterelements ausgebildeten Elektrode elektrisch verbunden ist, einen zweiten Elektrodenabschnitt, der mit einer an einer externen Schaltung ausgebildeten Elektrode elektrisch verbunden ist, einen Verdrahtungsabschnitt, der den ersten Elektrodenabschnitt mit dem zweiten Elektrodenabschnitt verbindet, und einen Verbindungsabschnitt gekennzeichnet ist, der bei einem Teil des Verdrahtungsabschnitts zur Verbindung des Verdrahtungsabschnitts ausgebildet ist, wobei der erste Elektrodenabschnitt, der zweite Elektrodenabschnitt, der Verdrahtungsabschnitt und der Verbindungsabschnitt aus einem plattenförmigen leitenden Körper ausgebildet sind und jeweils die Dicke des ersten Elektrodenabschnitts, des zweiten Elektrodenabschnitts und des Verdrahtungsabschnitts nicht größer als die Hälfte der Dicke des Verbindungsabschnitts ausgeführt ist.

Der Verbindungsabschnitt kann ein Abschnitt sein, bei dem der Verdrahtungsabschnitt und entweder der erste Elektrodenabschnitt oder der zweite Elektrodenabschnitt, der breiter als der Verdrahtungsabschnitt ist, sich gegenseitig überlappen.

Außerdem können die Verbindungsabschnitte, die entweder den ersten Elektrodenabschnitt oder den zweiten Elektrodenabschnitt aufweisen und an benachbarten Verdrahtungsabschnitten ausgebildet sind, derart angeordnet werden, daß sie nicht nebeneinander ausgerichtet sind.

Der Verdrahtungsabschnitt kann aus dem plattenförmigen leitenden Körper durch Ätzen ausgebildet werden.

Zumindest eine Oberfläche des ersten Elektrodenabschnitts oder des zweiten Elektrodenabschnitts kann nicht dem Ätzweg ausgesetzt worden sein.

Der Leiterraum gemäß der Erfindung ist mit einer Vielzahl von Verdrahtungsstellen versehen.

Die Erfindung wird nachstehend anhand von Ausführungsbeispielen, die bezugnehmend auf die beiliegende Zeichnung näher beschrieben werden, gezeigt.

Fig. 1 eine Schnittansicht eines Leiterraums gemäß einem ersten Ausführungsbeispiel.

Fig. 2 eine Draufsicht des Leiterraums gemäß dem ersten Ausführungsbeispiel.

Fig. 3 eine Schnittansicht des Leiterraums gemäß dem ersten Ausführungsbeispiel.

Fig. 4 eine Draufsicht des Leiterraums gemäß dem ersten Ausführungsbeispiel.

Fig. 5 eine Draufsicht des Leiterraums gemäß dem ersten Ausführungsbeispiel.

Fig. 6 eine Draufsicht des Leiterraums gemäß dem ersten Ausführungsbeispiel.

Fig. 7 eine Draufsicht des Leiterraums gemäß dem ersten Ausführungsbeispiel.

Fig. 8 eine Draufsicht des Leiterraums gemäß dem ersten Ausführungsbeispiel.

Fig. 9 eine Draufsicht des Leiterraums gemäß dem ersten Ausführungsbeispiel.

Fig. 10 eine Draufsicht des Leiterraums gemäß dem ersten Ausführungsbeispiel.

Fig. 11 eine Draufsicht des Leiterraums gemäß dem ersten Ausführungsbeispiel.

Fig. 12 eine Draufsicht des Leiterraums gemäß dem ersten Ausführungsbeispiel.

Fig. 13 eine Draufsicht des Leiterraums gemäß dem ersten Ausführungsbeispiel.

Fig. 14 eine Draufsicht des Leiterraums gemäß dem ersten Ausführungsbeispiel.

Fig. 15 eine Draufsicht des Leiterraums gemäß dem ersten Ausführungsbeispiel.

Fig. 16 eine Draufsicht des Leiterraums gemäß dem ersten Ausführungsbeispiel.

Fig. 17 eine Draufsicht des Leiterraums gemäß dem ersten Ausführungsbeispiel.

Fig. 18 eine Draufsicht des Leiterraums gemäß dem ersten Ausführungsbeispiel.

Fig. 19 eine Draufsicht des Leiterraums gemäß dem ersten Ausführungsbeispiel.

Fig. 20 eine Draufsicht des Leiterraums gemäß dem ersten Ausführungsbeispiel.

Fig. 21 eine Draufsicht des Leiterraums gemäß dem ersten Ausführungsbeispiel.

Fig. 22 eine Draufsicht des Leiterraums gemäß dem ersten Ausführungsbeispiel.

Fig. 23 eine Draufsicht des Leiterraums gemäß dem ersten Ausführungsbeispiel.

Fig. 24 eine Draufsicht des Leiterraums gemäß dem ersten Ausführungsbeispiel.

Fig. 25 eine Draufsicht des Leiterraums gemäß dem ersten Ausführungsbeispiel.

Fig. 26 eine Draufsicht des Leiterraums gemäß dem ersten Ausführungsbeispiel.

Fig. 27 eine Draufsicht des Leiterraums gemäß dem ersten Ausführungsbeispiel.

Fig. 28 eine Draufsicht des Leiterraums gemäß dem ersten Ausführungsbeispiel.

Fig. 29 eine Draufsicht des Leiterraums gemäß dem ersten Ausführungsbeispiel.

Fig. 30 eine Draufsicht des Leiterraums gemäß dem ersten Ausführungsbeispiel.

Fig. 31 eine Draufsicht des Leiterraums gemäß dem ersten Ausführungsbeispiel.

Fig. 32 eine Draufsicht des Leiterraums gemäß dem ersten Ausführungsbeispiel.

Fig. 33 eine Draufsicht des Leiterraums gemäß dem ersten Ausführungsbeispiel.

Fig. 34 eine Draufsicht des Leiterraums gemäß dem ersten Ausführungsbeispiel.

Fig. 35 eine Draufsicht des Leiterraums gemäß dem ersten Ausführungsbeispiel.

Fig. 36 eine Draufsicht des Leiterraums gemäß dem ersten Ausführungsbeispiel.

Fig. 37 eine Draufsicht des Leiterraums gemäß dem ersten Ausführungsbeispiel.

Fig. 38 eine Draufsicht des Leiterraums gemäß dem ersten Ausführungsbeispiel.

Fig. 39 eine Draufsicht des Leiterraums gemäß dem ersten Ausführungsbeispiel.

Fig. 40 eine Draufsicht des Leiterraums gemäß dem ersten Ausführungsbeispiel.

Fig. 41 eine Draufsicht des Leiterraums gemäß dem ersten Ausführungsbeispiel.

Fig. 42 eine Draufsicht des Leiterraums gemäß dem ersten Ausführungsbeispiel.

Fig. 43 eine Draufsicht des Leiterraums gemäß dem ersten Ausführungsbeispiel.

Fig. 44 eine Draufsicht des Leiterraums gemäß dem ersten Ausführungsbeispiel.

Fig. 45 eine Draufsicht des Leiterraums gemäß dem ersten Ausführungsbeispiel.

delt, die aus einem Lötanschluß herzustellen ist, 15 ein Ver-  
bindungs- oder Übertragungs-  
element 8 angebracht ist, 101 eine Führungsstange und  
102 einen Leiterrahmen.

Fig. 3 zeigt eine Schnittansicht, die den Herstellungsvorgang des Leiterrahmens gemäß dem Ausführungsbeispiel darstellt. Bei dieser Darstellung bezeichnet die Bezugszahl 3 Aitzmasken, T die Dicke der leitenden Metallplatte 1, T1 die von der Oberfläche (rückwärtigen Oberfläche) der leitenden Metallplatte 1 geätzte Dicke, an der die Verdrahtungsabschnitte 2 nicht ausgebildet sind, T2 die Dicke der Verdrahtungsabschnitte, die durch Ätzen dünner ausgeführt werden, M1 ein Maskierungsmuster der Aitzmaske 3 zur Ausbildung der Verdrahtungsabschnitte 2 und M2 eine Öffnung der Aitzmaske 3 zur Ausbildung des Abstands zwischen den Verdrahtungsabschnitten 2. Das Bezugszeichen W1 bezeichnet die Breite eines durch das Maskierungsmuster M1 ausgebildeten mittleren Abschnitts des Verdrahtungsabschnitts 2 in der Richtung der Dicke, wobei lediglich aufgrund der geätzten Seiten die Dicke kleiner als das Maskierungsmuster M1 ist. Das Bezugszeichen W2 bezeichnet den Abstand zwischen den durch Ätzen ausgebildeten Verdrahtungsabschnitten 2, wobei der Abstand lediglich aufgrund der geätzten Seiten größer als die Öffnung M2 ist. Die Bezugszeichen A und B bezeichnen Ätztrennzflächen, die die Mustergrenzflächen an den durch Ätzen von der unteren Oberfläche des Verdrahtungsabschnitts 2, das heißt von den von der rückwärtigen Oberfläche der leitenden Metallplatte 1 ausgebildeten Oberflächen sind. Der Leiterrahmen wird durch Ausbildung der Aitzmasken 3 mit einem vorbestimmten Muster an beiden Oberflächen der leitenden Metallplatte 1 erhalten, wobei das Ätzen an beiden Oberflächen gleichzeitig gestartet wird, das Ätzen ausgesetzt wird, wenn die leitende Metallplatte 1 teilweise durchdrungen ist und die vorbestimmten Ätztenden A und B erhalten werden, und schließlich die Aitzmasken 3 entfernt werden. Dabei wird die Ätztiefe T1 von der rückwärtigen Oberfläche größer als die Hälfte der Dicke T der leitenden Metallplatte 1 und die Dicke T2 der Verdrahtungsabschnitte 2 kleiner als die Hälfte der Dicke T der leitenden Metallplatte 1.

Gemäß Fig. 3 sind die Verdrahtungsabschnitte 2 lediglich an einer Seite der leitenden Metallplatte 1 vorgesehen, jedoch können wie in Fig. 4 gezeigt die Verdrahtungsabschnitte 2a und die Verdrahtungsabschnitte 2b jeweils abwechselnd auf der ersten und der zweiten Seite der leitenden Metallplatte 1 vorgesehen werden, wodurch weiter die Leiterunterteilungsbreite verringert wird. Gemäß dieser Darstellung bezeichnet die Bezugszahl 2a Verdrahtungsabschnitte für die erste Seite der leitenden Metallplatte 1, 2b Verdrahtungsabschnitte für die zweite Seite der leitenden Metallplatte 1, M3 eine Öffnung für die Aitzmasken 3 zur Ausbildung des Abstands zwischen den Verdrahtungsabschnitten 2a oder zwischen den Verdrahtungsabschnitten 2b, die an unterschiedlichen Seiten der leitenden Metallplatte 1 ausgebildet sind.

Fig. 5 und 6 zeigen Schnittansichten eines Leiters des Leiterrahmens gemäß diesem Ausführungsbeispiel. Da beide Oberflächen des ersten Elektrodenabschnitts 4 und des zweiten Elektrodenabschnitts 5 mit den Aitzmasken 3 während des Ätzvorgangs bedeckt sind, weisen sowohl der erste Elektrodenabschnitt 4 als auch der zweite Elektrodenabschnitt 5 dieselbe Dicke wie die leitende Metallplatte 1 auf. Obwohl eine Seite des ersten Elektrodenabschnitts 4 mit

Elektrodenabschnitt 5 ausgeführt.

(Anschlußoberflächen 4a und 5a des ersten Elektrodenabschnitts 4 und des zweiten Elektrodenabschnitts 5 an denselben Seiten der leitenden Metallplatte 1 ausgebildet sind, wohingegen Fig. 6 den Fall zeigt, bei dem die Verbindungs-  
oberflächen 4a und 4b an unterschiedlichen Seiten der leitenden Metallplatte 1 angeordnet sind. Da beide Seiten des ersten Elektrodenabschnitts 4 und des zweiten Elektrodenabschnitts 5 nicht geätzte ebene Oberflächen der leitenden Metallplatte 1 sind, wird kein Trennen beim Bonden verursacht. Deshalb können die Verbindungs-  
oberflächen des ersten Elektrodenabschnitts 4 und des zweiten Elektrodenabschnitts 5 wie gewünscht ausgewählt werden.

Bei dem Leiterrahmen gemäß diesem Ausführungsbeispiel wird ein Ätzen von beiden Seiten der leitenden Metallplatte 1 durchgeführt, wodurch die Verdrahtungsabschnitte 2 nicht dicker als die Hälfte der Dicke der leitenden Metallplatte 1 ausgeführt werden. Folglich kann das Ätzen unter den Bedingungen durchgeführt werden, daß der Abstand W2 zwischen den Verdrahtungsabschnitten 2 oder der Abstand W3 zwischen den Verdrahtungsabschnitten 2a und 2b derselbe wie die Dicke T2 der Verdrahtungsabschnitte 2, 2a und 2b ist. Folglich kann, selbst wenn die Leiterunterteilungsbreite doppelt so dick ausgeführt wird, wie die Dicke T2 normalerweise ist, diese kleiner als die Dicke T der leitenden Metallplatte 1 sein.

Gemäß diesem Ausführungsbeispiel können die zweiten Elektrodenabschnitte 5 an der Innenseite der ersten Elektrodenabschnitts 4, das heißt an der Rückseite der an den Befestigungselementen 20 angebrachten Halbleiterelemente 8 angeordnet werden. Folglich kann eine verkleinerte Halbleitervorrichtung erhalten werden.

Außerdem kann der Vorgang unter den Bedingungen durchgeführt werden, daß der Abstand zwischen den Verdrahtungsabschnitten 2 etwa genauso groß ist wie die Dicke T2 der Verdrahtungsabschnitte 2, indem die Dicke T2 der Verdrahtungsabschnitte 2 dünner ausgeführt wird. Deshalb kann die Leiterunterteilungsbreite verkürzt werden, wobei eine Feinverdrahtung möglich wird. Zusätzlich kann, wenn die Verdrahtungsabschnitte 2a der ersten Seite der leitenden Metallplatte 1 und die Verdrahtungsabschnitte 2b der zweiten Seite der leitenden Metallplatte 1 abwechselnd angeordnet werden, der Abstand W3 zwischen benachbarten an unterschiedlichen Seiten der leitenden Metallplatte 1 ausgebildeten Verdrahtungsabschnitten 2a und 2b kleiner als der Abstand W2 der Verdrahtungsabschnitte 2 ausgeführt werden, wobei folglich die Leiterunterteilungsbreite weiter verkleinert werden kann. Außerdem können die Verbindungs-  
oberflächen des ersten Elektrodenabschnitts 4 und der zweiten Elektrodenabschnitts 5 derart wie gewünscht bestimmt werden, daß die Flexibilität der Anordnung der Halbleiterelemente, Elektroden und der Anoden-Elektroden der Halbleitervorrichtung erhöht wird.

#### Zweiter Ausführungsbeispiel

Gemäß dem ersten Ausführungsbeispiel weisen die ersten Elektrodenabschnitte 4 und die zweiten Elektrodenabschnitte 5 dieselbe Dicke wie die leitende Metallplatte 1 auf. Jedoch kann wie in Fig. 7 und 8 gezeigt der Abstand zwischen dem zweiten Elektrodenabschnitt 5 in derselben Weise wie die Verdrahtungsabschnitte 2 durch eine dünnere

Genau wie in der Verbindungsoberfläche 5a des zweiten Elektrodenabschnitts 5 an der gesamten bzw. verbleibenden Verbindungsoberfläche durch Anwenden eines Pressens an dem zweiten Elektrodenabschnitt 5 eben ausgeführt werden, was herkömmlich ausgeführt wurde, um ein Leiterende eben auszuführen, ohne das ein Problem beim Bonden verursacht wird. Jedoch wird, falls der zweite Elektrodenabschnitt 5 durch Pressen dünner ausgeführt wird, wenn der zweite Elektrodenabschnitt 5 eine Dicke  $T_1$ , eine Leiterbreite  $W_1$  und eine Verringerungsgröße  $\Delta T_2$  aufweist,  $\Delta T_2$  gleich  $\epsilon \cdot T_2$ , wobei die erhöhte Leiterbreite gleich  $\epsilon \cdot (W_1/T_2) \cdot (T_1 - W_1)$  wird, was anzeigt, daß der Leiterabstand lediglich aufgrund der erhöhten Leiterbreite kleiner wird. Deshalb sollte der Preßvorgang, um der zweiten Elektrodenabschnitt 5 dünner auszuführen, nur soweit durchgeführt werden, um die abgeätzte Oberfläche eben auszuführen.

Gemäß dem ersten Ausführungsbeispiel kann der Abstand zwischen den zweiten Elektrodenabschnitten 5 kleiner ausgeführt werden, indem der zweite Elektrodenabschnitt 5 dünner ausgeführt wird. Folglich kann eine verkleinerte Halbleitervorrichtung erhalten werden.

#### Drittes Ausführungsbeispiel

Gemäß dem zweiten Ausführungsbeispiel sind die zweiten Elektrodenabschnitte 5 dünner ausgeführt. Jedoch kann der Abstand zwischen den ersten Elektrodenabschnitten 4 kleiner ausgeführt werden, indem die ersten Elektrodenabschnitte 4 wie die Verdrahtungsanschnitte 2 durch Ätzen von einer Seite bei dem Ätzworgang dünner ausgeführt werden.

Gemäß Fig. 9 ist die Verbindungsoberfläche 4a des ersten Elektrodenabschnitts 4 an der Seite vorgesehen, die nicht geätzt wurde, jedoch kann wie in Fig. 10 gezeigt, wenn es erforderlich ist, die Verbindungsoberfläche 4a des ersten Elektrodenabschnitts 4 an der geätzten Seite vorzusehen, die Verbindungsoberfläche durch einen Preßvorgang in derselben Weise wie gemäß dem zweiten Ausführungsbeispiel eben ausgeführt werden, ohne daß ein Problem beim Bonden verursacht wird.

Gemäß diesem Ausführungsbeispiel kann der Abstand zwischen den Elektroden kleiner ausgeführt werden, indem die ersten Elektrodenabschnitte 4 dünner ausgeführt werden. Folglich kann gemäß diesem Ausführungsbeispiel dem Wunsch nach einer großen Anzahl von Stiften (Anschlüssen, Elektroden) und einer kürzeren Unterteilungsbreite bei dem Halbleiterelement entsprochen werden.

#### Viertes Ausführungsbeispiel

Fig. 11 und 12 zeigen eine Draufsicht und eine Seitenansicht eines Leiters des Leiterrahmens gemäß dem vierten Ausführungsbeispiel. Gemäß diesen Darstellungen bezeichnen die Bezugszahlen 2a und 2b Verdrahtungsanschnitte, die durch Ätzen von einer Seite bei Ausprägung des Leiterrahmens dünner ausgeführt worden sind. Dabei bezeichnen die Bezugszahl 2a einen an der ersten Seite der leitenden Metallplatte 1 ausgebildeten Verdrahtungsabschnitt und 2b einen an der zweiten Seite der leitenden Metallplatte 1 ausgebildeten Verdrahtungsabschnitt. Die Bezugszahl 4 bezeichnet einen ersten Elektrodenabschnitt und 5 einen zweiten Elektrodenabschnitt, wobei beide dünner ausgeführt sind. Die Bezugszahl 6 bezeichnet einen Verbindungsabschnitt.

schnitte außer dem Verbindungsabschnitt 6 des Leiters

Feinverdrahtung ermöglicht. Wie in Fig. 12 gezeigt ermöglicht die Verwendung des Verbindungsabschnitts 6 eine Anordnung des ersten Elektrodenabschnitts 4 und des Verdrahtungsabschnitts 2a an der ersten Seite der leitenden Metallplatte 1 sowie eine Anordnung des zweiten Elektrodenabschnitts 5 und des Verdrahtungsabschnitts 2b an der zweiten Seite der leitenden Metallplatte 1, wodurch eine dreidimensionale verteilte Anordnung erreicht wird. Folglich kann eine Verdrahtung mit einer höheren Dichte verwirklicht und eine verkleinerte Halbleitervorrichtung erreicht werden.

#### Fünftes Ausführungsbeispiel

Gemäß dem vierten Ausführungsbeispiel sind der erste Elektrodenabschnitt 4, der zweite Elektrodenabschnitt 5 und die Verdrahtungsanschnitte 2a und 2b in einer Geraden angeordnet. Jedoch können wie in Fig. 13 bis 15 gezeigt die ersten Elektrodenabschnitt 4 und die zweiten Elektrodenabschnitt 5 an jeder beliebigen Position durch Anordnen der ersten Elektrodenabschnitte 4 und die zweiten Elektrodenabschnitt 5 verbindenden Verdrahtungsanschnitte 2a und 2b derart, daß sich die Richtung der Verdrahtungsanschnitte 2a und 2b in der Mitte um einen rechten Winkel ändern. Folglich kann die Flexibilität der Anordnung der Halbleiterelementelektroden und der Außenelektroden der Halbleitervorrichtung erhöht werden, was eine weitere Verkleinerung der Halbleitervorrichtung ermöglicht.

Fig. 13 und 14 zeigen eine Draufsicht und eine Seitenansicht eines Leiters, der anwendbar ist, wenn der erste Elektrodenabschnitt 4, der zweite Elektrodenabschnitt 5 und die Verdrahtungsanschnitte 2a und 2b nicht geradlinig verlaufen. Fig. 15 zeigt eine perspektivische Ansicht eines Leiters, der anwendbar ist, wenn es erforderlich ist, die Verdrahtungsanschnitte 2a und 2b mit einem rechten Winkel anzuschließen.

Gemäß diesem Ausführungsbeispiel können der erste Elektrodenabschnitt 4 und der zweite Elektrodenabschnitt 5 derart in jeder beliebigen Lage angeordnet werden, daß die Flexibilität der Anordnung der Halbleiterelementelektroden und der Außenelektroden der Halbleitervorrichtung erhöht wird, was eine weitere Verkleinerung der Halbleitervorrichtung ermöglicht.

#### Sechstes Ausführungsbeispiel

Fig. 16 zeigt eine Schnittansicht eines Leiterrahmens gemäß dem sechsten Ausführungsbeispiel, wobei Fig. 17 und 18 eine Draufsicht und eine Seitenansicht eines Leiters des in Fig. 16 gezeigten Leiterrahmens darstellen. Da die Bezugszahlen bei diesen Darstellungen dieselben Bauelemente wie die gemäß Fig. 1 bezeichneten erhalteten, deren Beschreibung nicht.

Wenn der erste Elektrodenabschnitt 4 und der zweite Elektrodenabschnitt 5 wie in Fig. 16 gezeigt nebeneinander angeordnet liegen, kann zur Verdrahtung ein wie in Fig. 17 und 18 gezeigter U-förmiger Leiter verwendet werden, wodurch eine verkleinerte Halbleitervorrichtung erhalten wird.

#### Siebttes Ausführungsbeispiel

Fig. 19 zeigt eine Draufsicht eines Leiterrahmens gemäß dem siebten Ausführungsbeispiel, wobei Fig. 20 eine Draufsicht

Bei dem Abschnitt, an dem ein Verdrahtungsabschnitt 2 mit einem zweiten Elektrodenabschnitt 5 sich überlappen, ist an der ersten Seite durch einen ein Freileitungsgerüst, der die Form des zweiten Elektrodenabschnitts 5 ist, wohingegen der Verdrahtungsabschnitt bzw. das Verdrahtungsmuster an der zweiten Seite durch einen ausgebildet ist. Hinsichtlich der anderen Punkte ist der Aufbau gemäß diesen Ausführungsbeispiel, wie gemäß dem vierten Ausführungsbeispiel, wobei gemäß diesem Ausführungsbeispiel ein Fall dargestellt ist, bei dem der zweite Elektrodenabschnitt 5 an dem in Fig. 11 gezeigten Verdrahtungsabschnitt 6 ausgebildet ist.

Genäß diesen Ausführungsbeispiel sind die Verdrahtungsabschnitte 2 und die zweiten Elektrodenabschnitte 5, die weiter als die Verdrahtungsabschnitte 2 sind, an voneinander unterschiedlichen Seiten ausgebildet, wobei zumindest ein Verdrahtungsabschnitt 2 zwischen benachbarten zweiten Elektrodenabschnitten 5 ausgebildet ist, damit die beiden zweiten Elektrodenabschnitte 5 nicht nebeneinander in einer Reihe ausgebildet sind. Folglich besteht keine Notwendigkeit, den Abstand zwischen den Verdrahtungsabschnitten 2 zur Ausbildung der zweiten Elektrodenabschnitte 5 zu vergrößern, was eine Verdrahtung mit einer höheren Dichte und eine verkleinerte Halbleitervorrichtung erreicht.

#### Achtes Ausführungsbeispiel

Genäß dem siebten Ausführungsbeispiel sind die zweiten Elektrodenabschnitte 5 und die Verdrahtungsabschnitte 2 überlappend. Jedoch können die Halbleiterelementelektroden eine kleiner Unterbreitungsweite aufweisen, indem die ersten Elektrodenabschnitte 4 und die Verdrahtungsabschnitte 2 an unterschiedlichen Seiten ausgebildet werden und ein Verdrahtungsabschnitt 2 zwischen benachbarten ersten Elektrodenabschnitten 4 derart angeordnet wird, daß die ersten Elektrodenabschnitte 4 nicht in einer Linie zueinander angeordnet sind.

Wie vorstehend beschrieben kann gemäß den Ausführungsbeispielen eine Feinverdrahtung erreicht werden, indem die Dicke des Leiter- als Verdrahtungsteil zur elektrischen Verbindung der Halbleiterelementelektroden mit den Außenelektroden der Halbleitervorrichtung nicht dicker als die Hälfte der erforderlichen Dicke des Leitertrahmenmaterials ausgeführt wird. Außerdem kann durch Verwendung eines Leitertrahmens, der die an beiden Seiten des Leitertrahmenmaterials angeordneten Verdrahtungs- und Elektrodenabschnitte aufweist, ein Halbleiterelement mit einer größeren Anzahl von Stiften und einer kleineren Unterbreitungsweite erreicht werden. Zusätzlich kann durch Anordnung der Außenelektroden an der rückwärtigen Seite der Halbleiterelemente eine kleiner Halbleiterstruktur mit niedrigeren Kosten erreicht werden.

Wie der vorstehend beschriebene zu einem anderen, wird ein Verdrahtungsteil mit einem ersten Elektrodenabschnitt 4, der mit einer an einer Oberfläche eines Halbleiterelements 8 ausgebildeten Elektrode elektrisch verbunden ist, einem zweiten Elektrodenabschnitt 5, der mit einer an einer externen Schaltung ausgebildeten Elektrode elektrisch verbunden ist, und einem Verdrahtungsabschnitt 2 geschaffen, der den ersten Elektrodenabschnitt 4 mit dem zweiten Elektrodenabschnitt 5 und der Verdrahtungsabschnitt 2 mit

Leiter als Verdrahtungsteil zur elektrischen Verbindung der Halbleiterelementelektroden 2 mit der externen Schaltung der Halbleitervorrichtung nicht größer als die Hälfte der erforderlichen Dicke des Leitertrahmenmaterials ausgeführt wird.

#### Patentsprache

##### Verdrahtungsteil, gekennzeichnet durch

einen ersten Elektrodenabschnitt (4), der mit einer an einer Oberfläche eines Halbleiterelements (8) ausgebildeten Elektrode (9) elektrisch verbunden ist, einen zweiten Elektrodenabschnitt (5), der mit einer an einer externen Schaltung ausgebildeten Elektrode elektrisch verbunden ist, und einen Verdrahtungsabschnitt (2), der den ersten Elektrodenabschnitt (4) mit dem zweiten Elektrodenabschnitt (5) verbindet,

wobei der erste Elektrodenabschnitt (4), der zweite Elektrodenabschnitt (5) und der Verdrahtungsabschnitt (2) aus einem plattenförmigen leitenden Körper (1) ausgebildet sind und die Dicke des Verdrahtungsabschnitts (2) nicht dicker als halb so dick wie der erste Elektrodenabschnitt (4) oder der zweite Elektrodenabschnitt (5) ausgeführt ist.

1. Verdrahtungsteil nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der Verdrahtungsabschnitt (2) an einer Oberfläche des plattenförmigen leitenden Körpers (1) vorgesehen ist.

2. Verdrahtungsteil nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Verdrahtungsabschnitte (2) verstreut an beiden Oberflächen des plattenförmigen leitenden Körpers (1) angeordnet sind.

3. Verdrahtungsteil nach einem der Ansprüche 1 bis 2, dadurch gekennzeichnet, daß die Dicke des ersten Elektrodenabschnitts (4) und die Dicke des zweiten Elektrodenabschnitts (5) dieselbe wie die des plattenförmigen leitenden Körpers (1) sind.

4. Verdrahtungsteil nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß die Dicke entweder des ersten Elektrodenabschnitts (4) oder des zweiten Elektrodenabschnitts (5) dieselbe wie die des plattenförmigen Körpers (1) ist, wobei die Dicke des anderen nicht mehr als die Hälfte der des plattenförmigen leitenden Körpers (1) beträgt.

5. Verdrahtungsteil nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, daß der erste Elektrodenabschnitt (4) oder der zweite Elektrodenabschnitt (5), deren Dicke nicht mehr als die Hälfte des plattenförmigen leitenden Körpers (1) beträgt, gepreßt wird, um deren Oberflächen eben auszuführen.

6. Verdrahtungsteil, gekennzeichnet durch einen ersten Elektrodenabschnitt (4), der mit einer an einer Oberfläche eines Halbleiterelements (8) ausgebildeten Elektrode (9) elektrisch verbunden ist, einen zweiten Elektrodenabschnitt (5), der mit einer an einer externen Schaltung ausgebildeten Elektrode elektrisch verbunden ist, einen Verdrahtungsabschnitt (2), der den ersten Elektrodenabschnitt (4) mit dem zweiten Elektrodenabschnitt (5) verbindet, und einen Verbindungsabschnitt (6), der bei einem Teil des Verdrahtungsabschnitts (2) zur Verbindung des Verdrahtungsabschnitts (2) ausgebildet ist.

wobei der erste Elektrodenabschnitt (4), der zweite Elektrodenabschnitt (5) und der Verdrahtungsabschnitt (2)

Dicke des Verbindungsabschnitts (6) ausgeführt ist.

8. Verdrahtungsteil nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, daß der Verbindungsabschnitt (6) ein Abschnitt ist, bei dem der Verdrahtungsabschnitt (2) und entweder der erste Elektrodenabschnitt (4) oder der zweite Elektrodenabschnitt (5), der breiter als der Verdrahtungsabschnitt (2) ist, sich gegenseitig überlappen.

9. Verdrahtungsteil nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, daß die Verbindungsabschnitte (6), die entweder den ersten Elektrodenabschnitt (4) oder den zweiten Elektrodenabschnitt (5) aufweisen und an benachbarten Verdrahtungsabschnitten (2) ausgebildet sind, hintereinander angeordnet sind, daß sie nicht nebeneinander angeordnet sind.

10. Verdrahtungsteil nach einem der Ansprüche von 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, daß der Verdrahtungsabschnitt (2) aus einem plattenförmigen leitenden Körper (1) durch Ätzen ausgebildet ist.

11. Verdrahtungsteil nach einem der Ansprüche 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, daß zumindest eine Oberfläche des ersten Elektrodenabschnitts (4) oder des zweiten Elektrodenabschnitts (5) nicht dem Ätzvorgang unterzogen worden ist.

12. Leiterraum, gekennzeichnet durch eine Vielzahl von Verdrahtungsteilen, wobei das Verdrahtungsteil einen ersten Elektrodenabschnitt (4), der mit einer an einer Oberfläche eines Halbleiterelements (8) ausgebildeten Elektrode (9) elektrisch verbunden ist, einen zweiten Elektrodenabschnitt (5), der mit einer an einer externen Schaltung ausgebildeten Elektrode elektrisch verbunden ist, und einen Verdrahtungsabschnitt (2) aufweist, der den ersten Elektrodenabschnitt (4) mit dem zweiten Elektrodenabschnitt (5) verbindet, wobei der erste Elektrodenabschnitt (4), der zweite Elektrodenabschnitt (5) und der Verdrahtungsabschnitt (2) aus einem plattenförmigen leitenden Körper (1) ausgebildet sind und die Dicke des Verdrahtungsabschnitts (2) nicht dicker als halb so dick wie der erste Elektrodenabschnitt (4) oder der zweite Elektrodenabschnitt (5) ausgeführt ist.

13. Leiterraum, gekennzeichnet durch eine Vielzahl von Verdrahtungsteilen, wobei das Verdrahtungsteil einen ersten Elektrodenabschnitt (4), der mit einer an einer Oberfläche eines Halbleiterelements (8) ausgebildeten Elektrode (9) elektrisch verbunden ist, einen zweiten Elektrodenabschnitt (5), der mit einer an einer externen Schaltung ausgebildeten Elektrode elektrisch verbunden ist, einen Verdrahtungsabschnitt (2), der den ersten Elektrodenabschnitt (4) mit dem zweiten Elektrodenabschnitt (5) verbindet, und einen Verbindungsabschnitt (6) aufweist, der bei einem Teil des Verdrahtungsabschnitts (2) zur Verbindung des Verdrahtungsabschnitts (2) ausgebildet ist,

wobei der erste Elektrodenabschnitt (4), der zweite Elektrodenabschnitt (5), der Verdrahtungsabschnitt (2) und der Verbindungsabschnitt (6) aus einem plattenförmigen leitenden Körper (1) ausgebildet sind und jeweils die Dicke des ersten Elektrodenabschnitts (4), des zweiten Elektrodenabschnitts (5) und des Verdrahtungsabschnitts (2) nicht größer als die Hälfte der Dicke des Verbindungsabschnitts (6) ausgeführt ist.

Hierzu 12) eine(n) Zeichnung(en)



FIG. 1

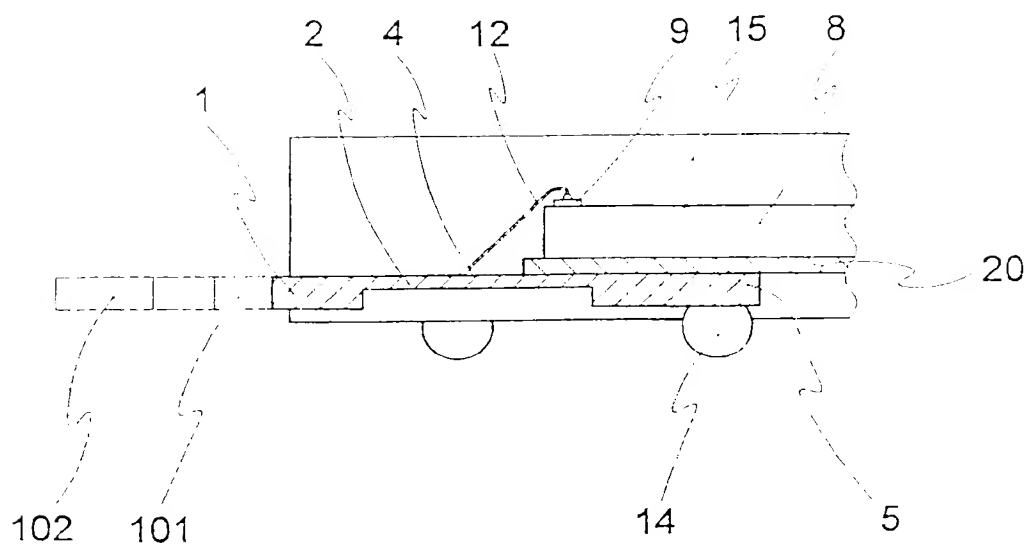


FIG. 2

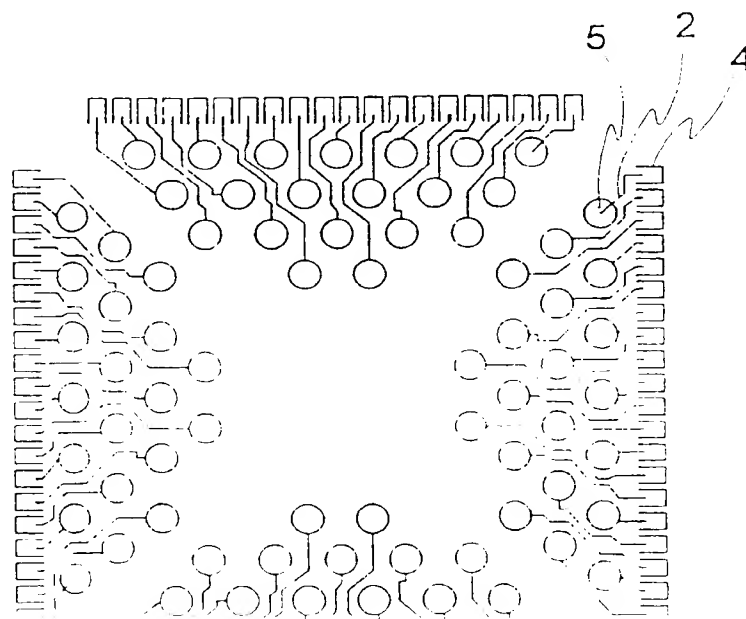


FIG. 3

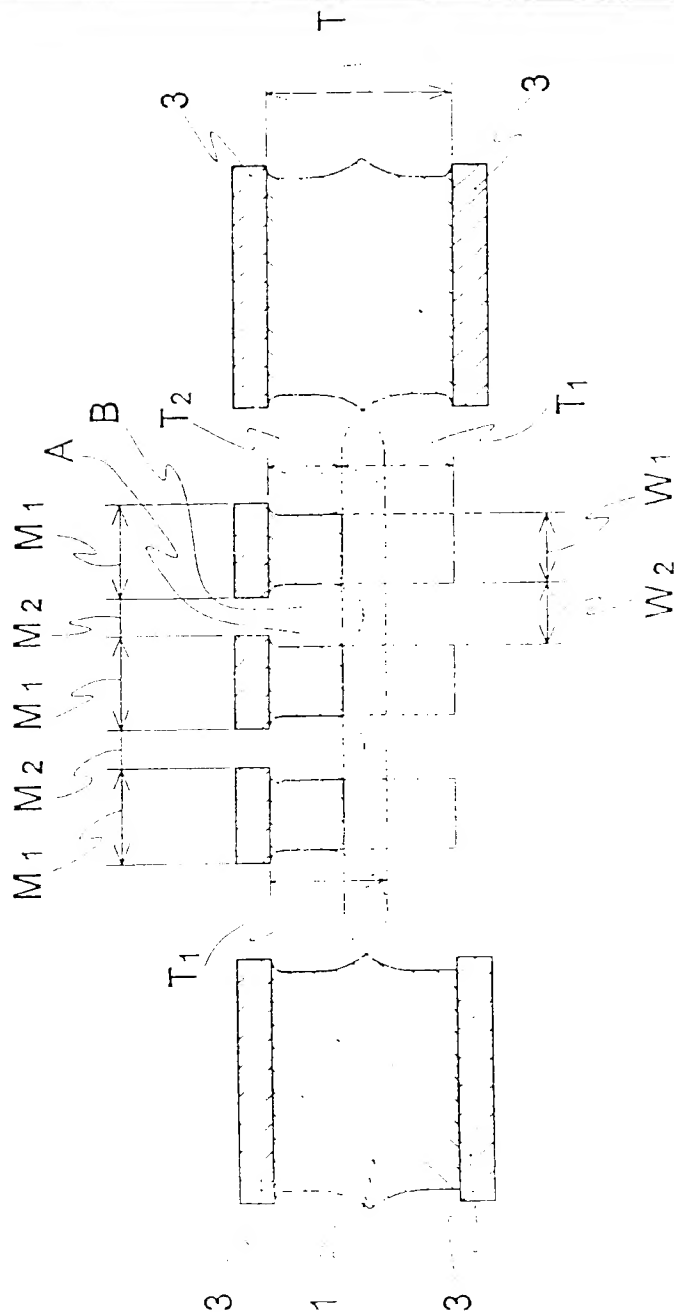


FIG. 4

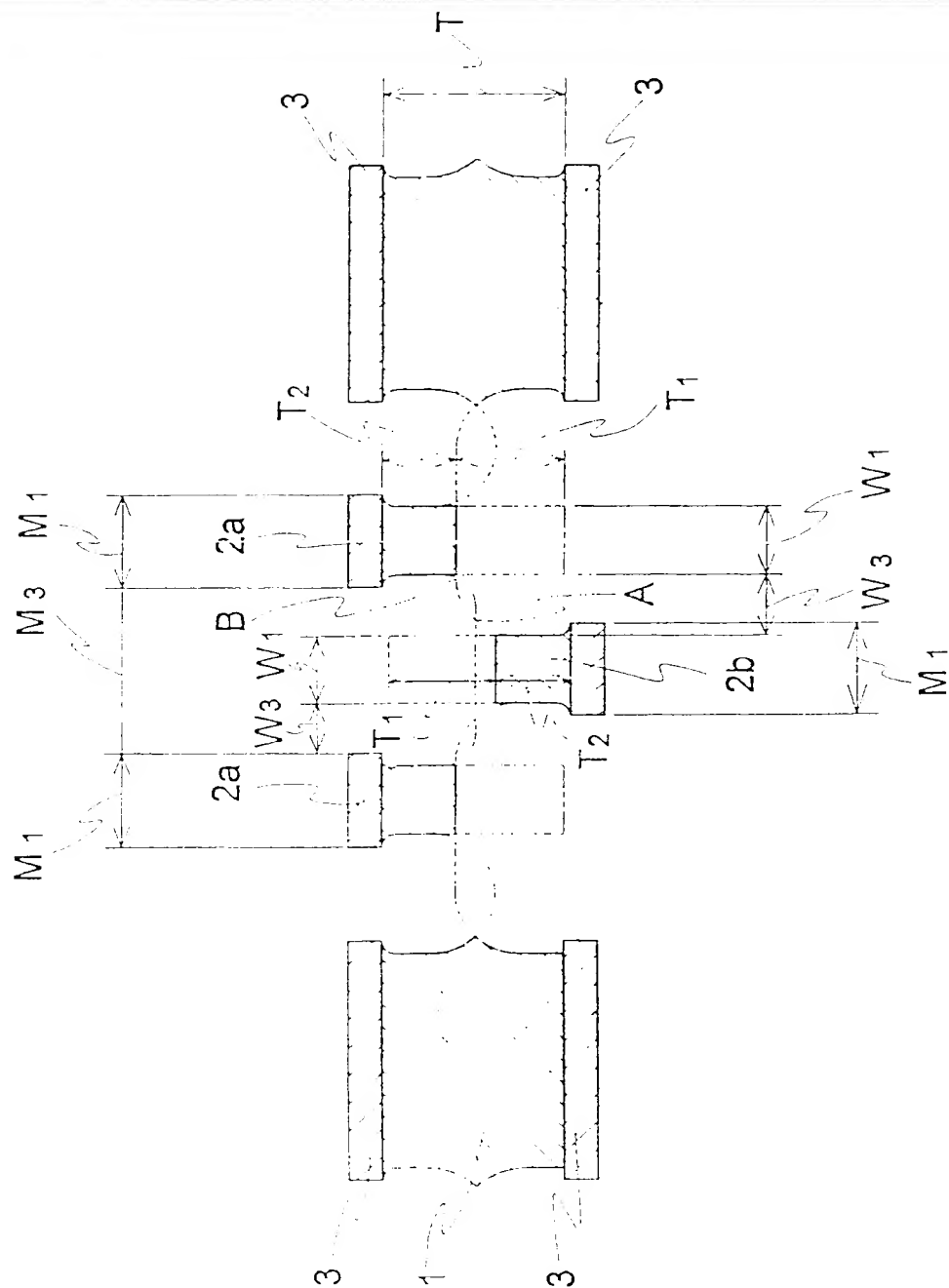


FIG. 5

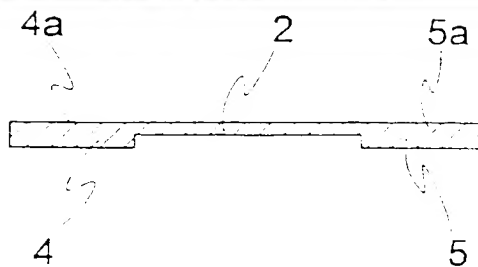


FIG. 6

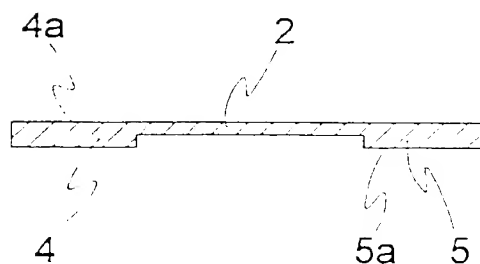


FIG. 7

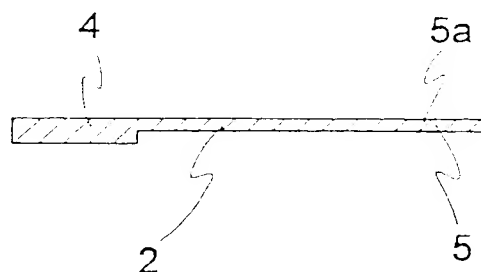


FIG. 8

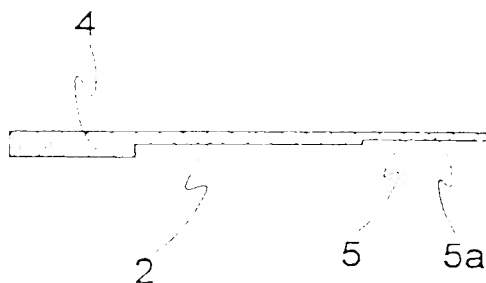


FIG. 9

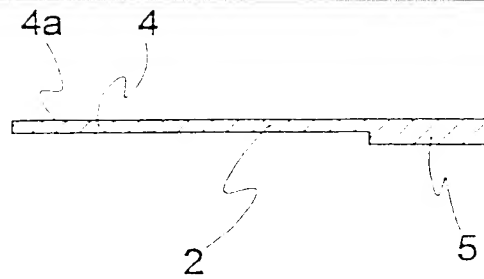


FIG. 10

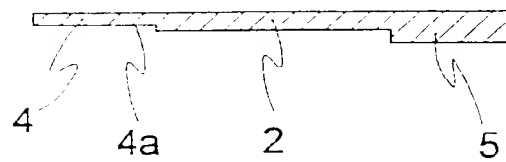


FIG. 11

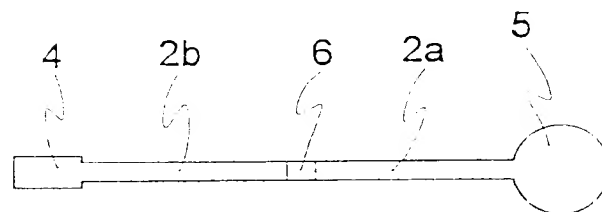


FIG. 12

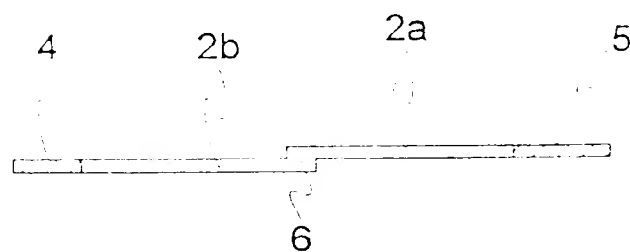


FIG. 13

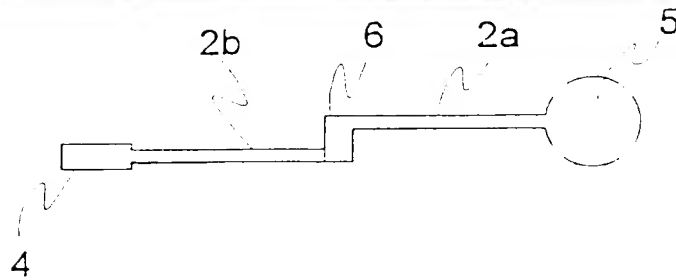


FIG. 14

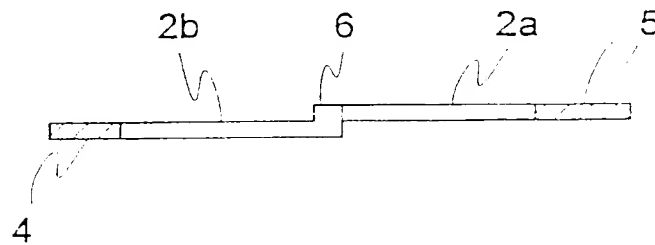


FIG. 15

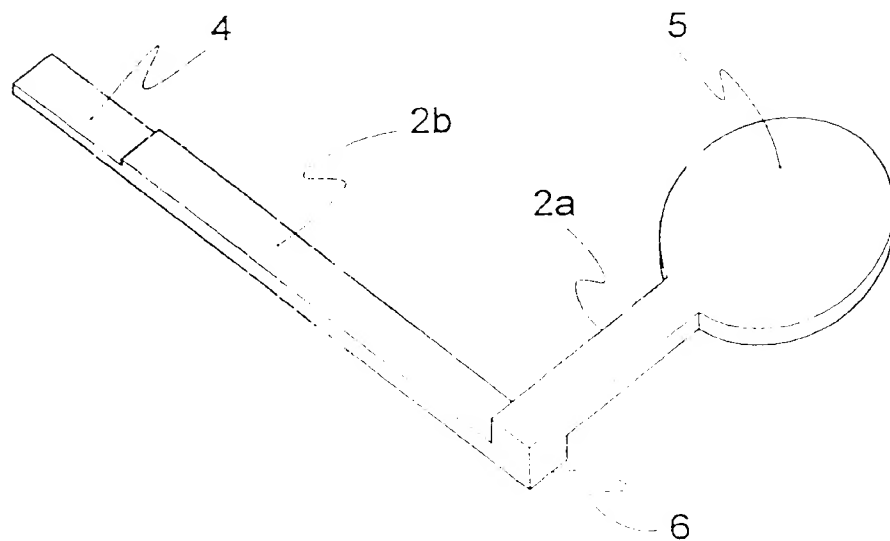


FIG. 16

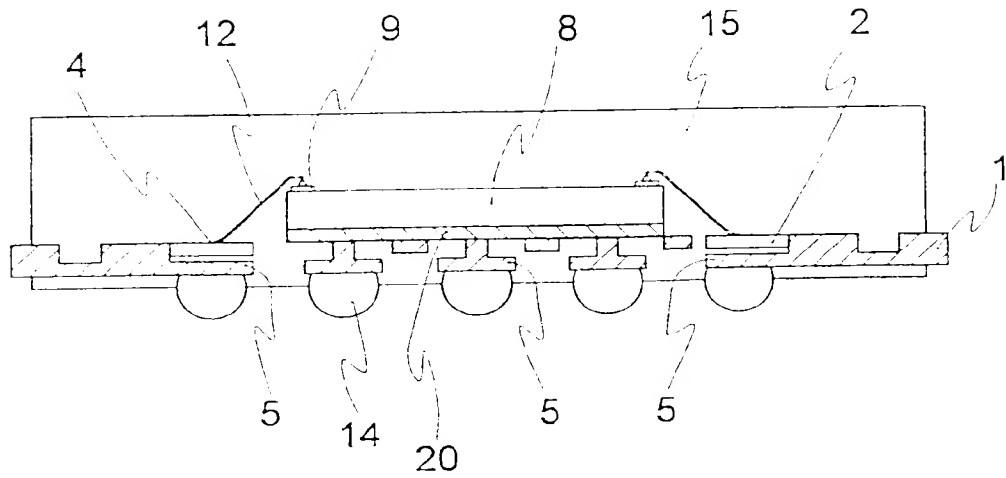


FIG. 17

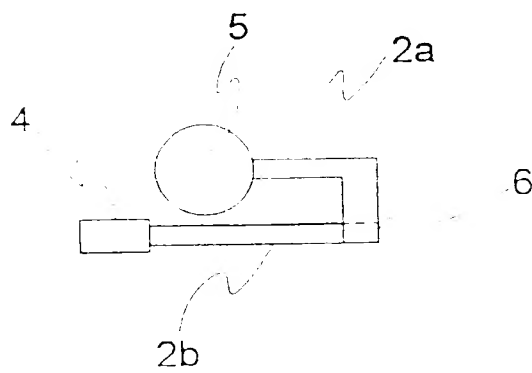


FIG. 18

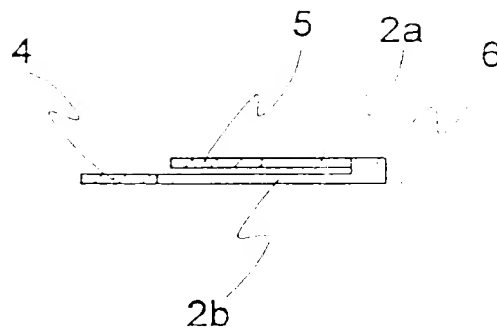


FIG. 19

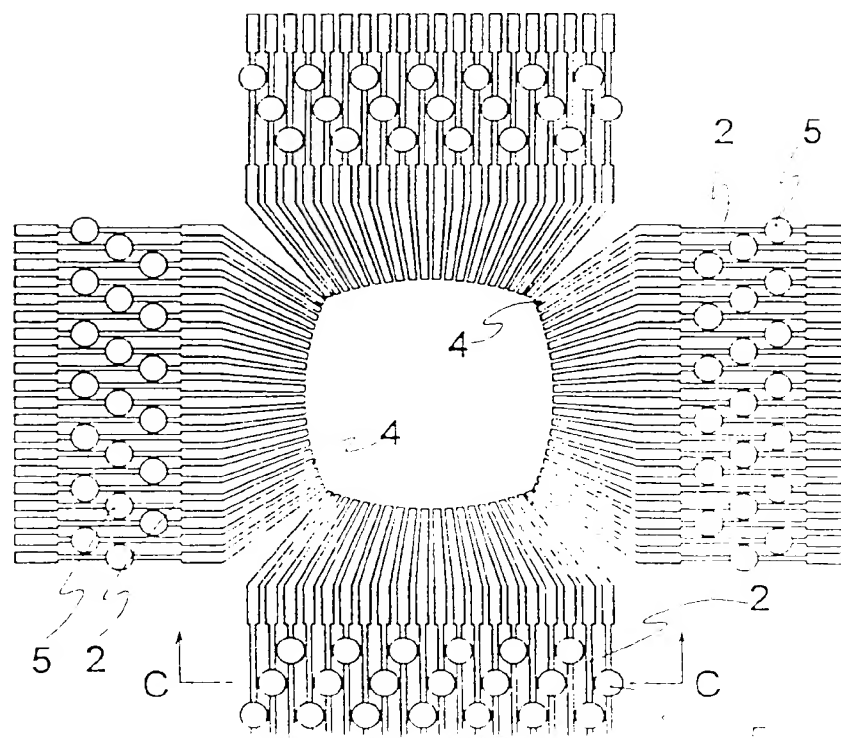




FIG. 20

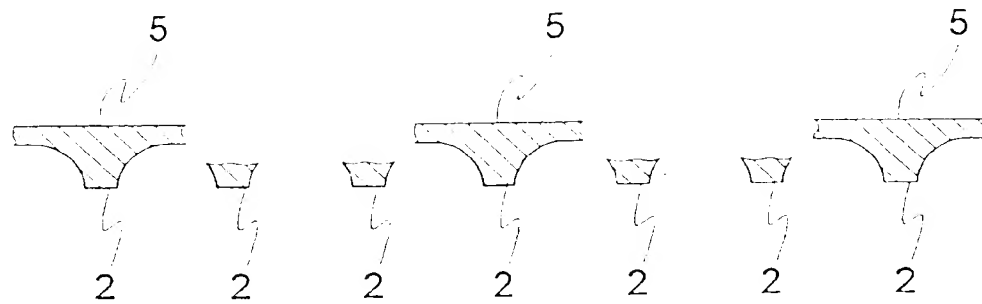


FIG. 21

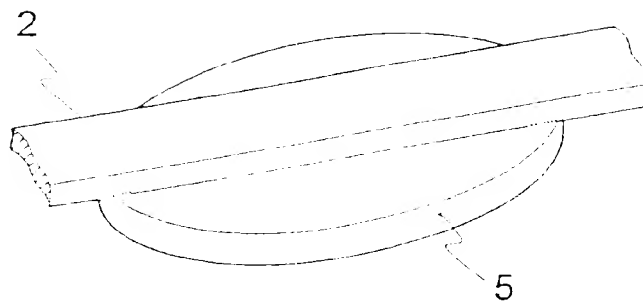


FIG. 22

(STAND DER TECHNIK)

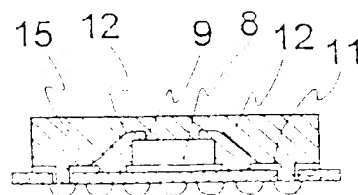


FIG. 23  
(STAND DER TECHNIK) 9 15

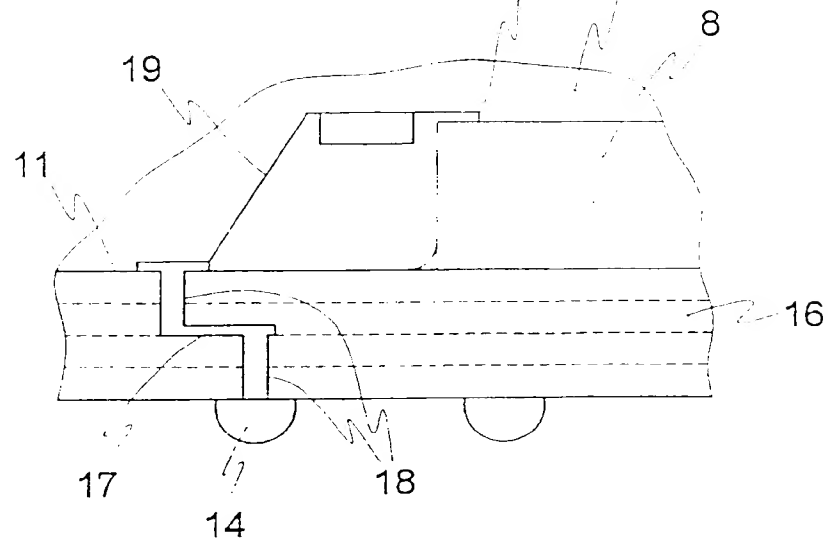


FIG. 24 (STAND DER TECHNIK)

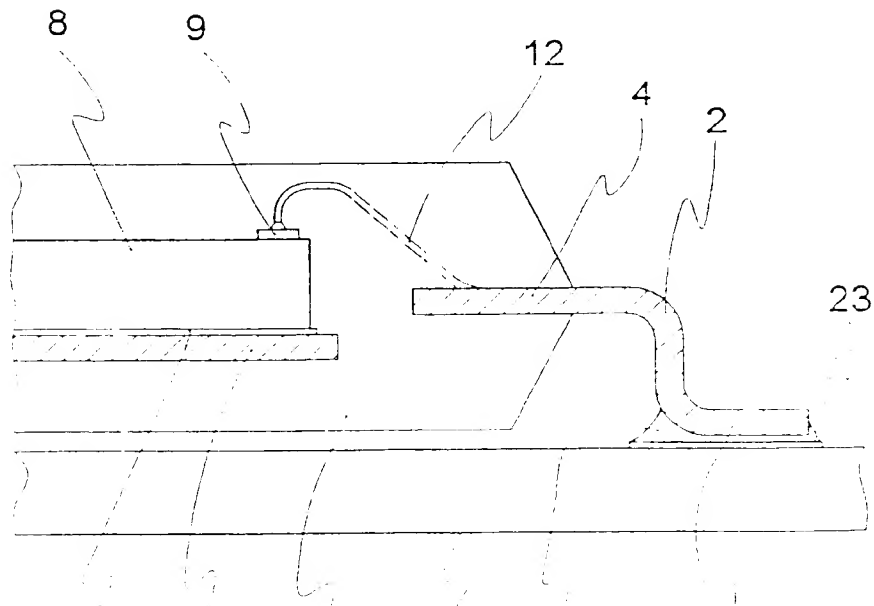


FIG. 25  
(STAND DER TECHNIK)

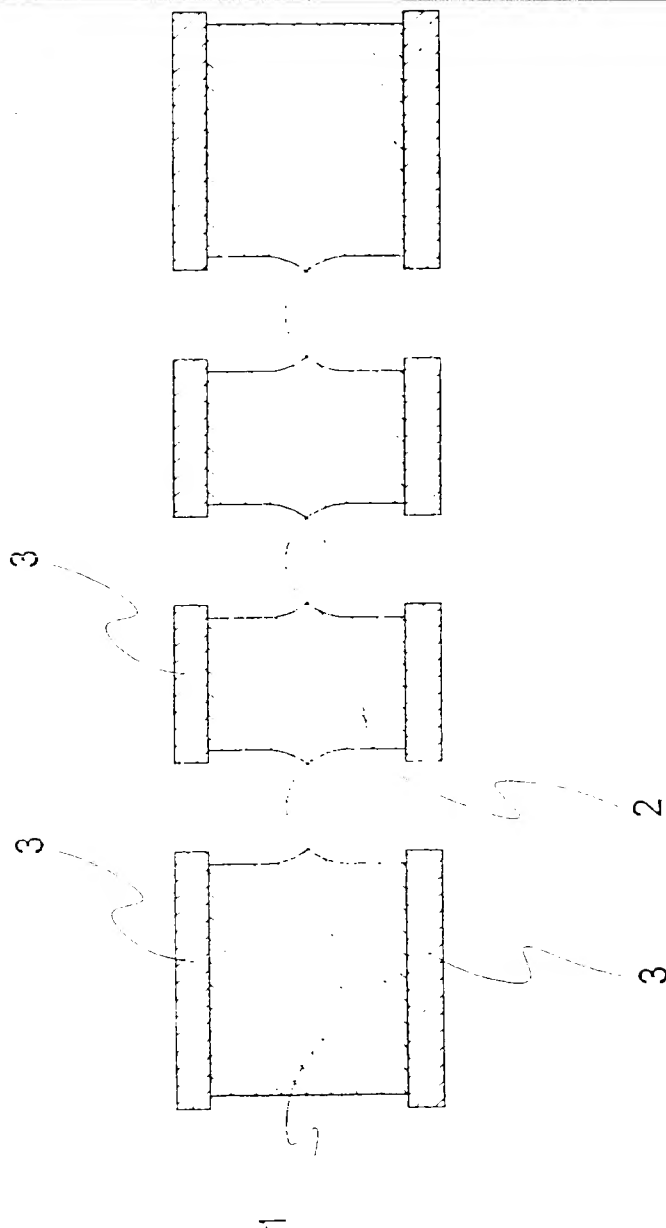


FIG. 26(a)

(STAND DER TECHNIK)

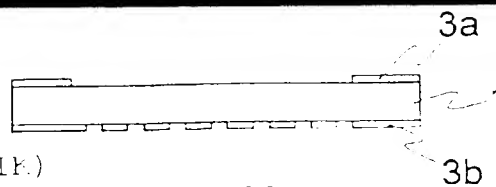


FIG. 26(b)

(STAND DER TECHNIK)

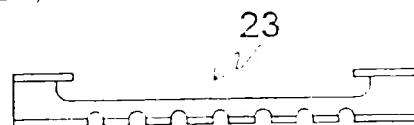


FIG. 26(c)

(STAND DER TECHNIK)

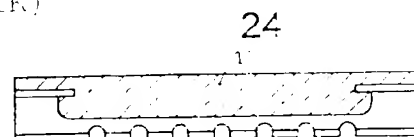


FIG. 26(d)

(STAND DER TECHNIK)

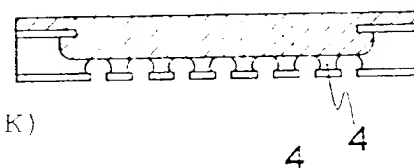


FIG. 26(e)

(STAND DER TECHNIK)

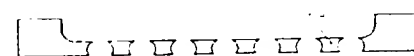


FIG. 27

(STAND DER TECHNIK)

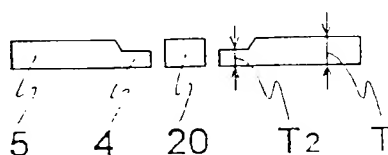


FIG. 28

